

### 关键指标

通带频率: DC~3GHz  
 插入损耗: 2.1dB  
 阻带衰减: 15.5dB@4.5GHz, 52dB@7GHz  
 回波损耗: 20dB  
 芯片尺寸: 1.8mm×0.8mm×0.1mm

### 产品简介

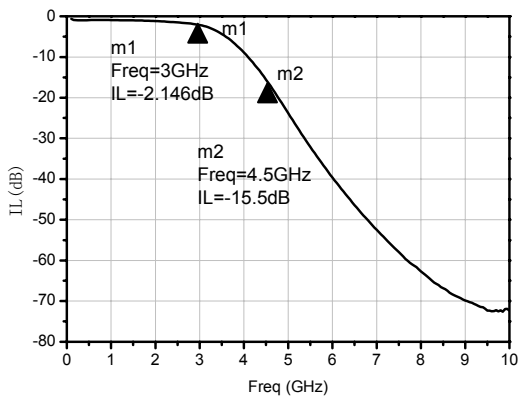
HG123LA 是一款低通滤波器芯片, 采用 GaAs pHEMT 工艺制作, 通带频率为 DC~3GHz, 带内插入损耗小于 2.1dB, 带内回波损耗为 20dB/20dB。

### 电性能 (T<sub>A</sub>=25°C)

指标	最小值	典型值	最大值
频率(GHz)	DC~3		
输入回波损耗(dB)	-	-	20
输出回波损耗(dB)	-	-	20
插入损耗(dB)	-	2.1	-
阻带衰减 @4.5GHz (dB)	-	15.5	-
阻带衰减 @7GHz(dB)	-	52	-

### 典型测试曲线

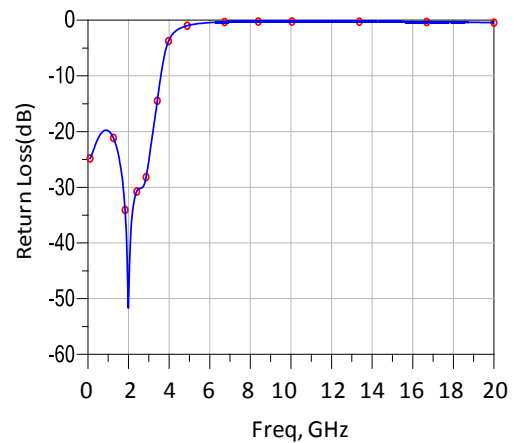
插入损耗



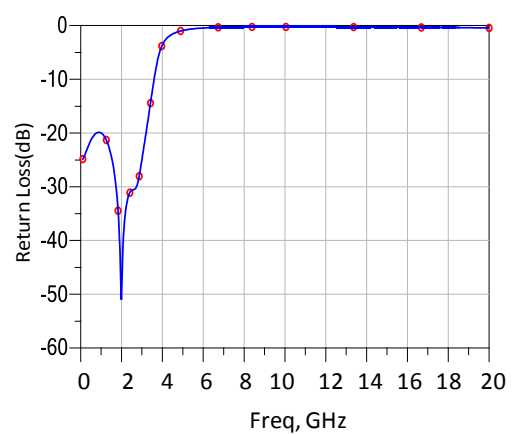
### 绝对额定最大值

最大输入功率	+27dBm
工作温度	-55°C~125°C
存储温度	-65°C~150°C

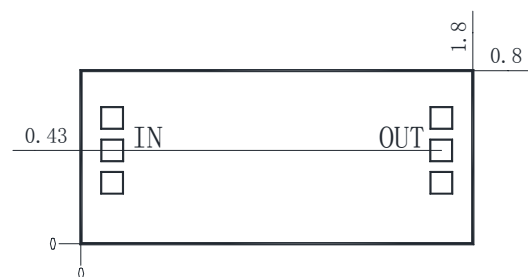
输入回波损耗



输出回波损耗



### 外形和端口尺寸 (mm)



### 注意事项

1. 芯片在干燥、氮气环境中存储, 在超净环境使用;
2. GaAs 材料较脆, 不能触碰芯片表面, 使用时必须小心;
3. 芯片用导电胶或合金烧结 (合金温度不能超过 300°C, 时间不能超过 30 秒), 使之充分接地;
4. 芯片微波端口与基片间隙不超过 0.05mm, 使用 Φ25μm 双金丝键合, 建议金丝长度 250~400μm;
5. 芯片微波端无隔直电容;
6. 芯片对静电敏感, 在储存和使用过程中注意防静电。